CMUDM8001

SURFACE MOUNT
P-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
SILICON MOSFET



APPLICATIONS:

- · Load/Power Switches
- Power Supply Converter Circuits
- Battery Powered Portable Equipment



www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMUDM8001 is a P-Channel Enhancement-mode Silicon MOSFET, manufactured by the P-Channel DMOS Process, designed for high speed pulsed amplifier and driver applications. This MOSFET offers Low r_{DS(ON)} and Low Theshold Voltage.

MARKING CODE: C8A

FEATURES:

- Power Dissipation 250mW
- Low rDS(ON)
- Low Threshold Voltage
- Logic Level Compatible
- Small, SOT-523 Surface Mount Package
- Complementary Device: CMUDM7001

MAXIMUM RATINGS: (T _A =25°C)	SYMBOL		UNITS
Drain-Source Voltage	V_{DS}	20	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	10	V
Continuous Drain Current (Steady State)	ID	100	mA
Continuous Drain Current	I_{D}	200	mA
Power Dissipation	P_{D}	250	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T _J , T _{stg}	-65 to +150	°C

FI FCTRICAL	CHARACTERISTICS:	(T ₄ =25°C unles	s otherwise noted)
LLLCINICAL	CHAINACHLINGHICG.		S ULITEI WISE HULEUI

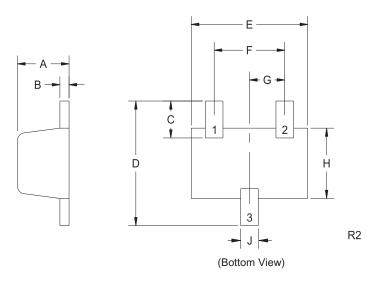
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I _{GSSF} , I _{GSSR}	V _{GS} =10V, V _{DS} =0			1.0	μΑ
I _{DSS}	$V_{DS}=20V, V_{GS}=0$			1.0	μΑ
BV_DSS	V _{GS} =0, I _D =100μA	20			V
V _{GS(th)}	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_{D}=250\mu A$	0.6		1.1	V
r _{DS(ON)}	V _{GS} =4.0V, I _D =10mA		1.9	8.0	Ω
r _{DS(ON)}	V_{GS} =2.5V, I_D =10mA		2.4	12	Ω
rDS(ON)	V_{GS} =1.5V, I_D =1.0mA			45	Ω
Q _{g(tot)}	V_{DS} =10V, V_{GS} =4.5V, I_{D} =100mA		0.658		nC
Q _{gs}	V_{DS} =10V, V_{GS} =4.5V, I_{D} =100mA		0.158		nC
Q_{gd}	V_{DS} =10V, V_{GS} =4.5V, I_{D} =100mA		0.181		nC
9FS	V_{DS} =10V, I_{D} =100mA	100			mS
C _{rss}	V_{DS} =3.0V, V_{GS} =0, f=1.0MHz		15		pF
C _{iss}	V_{DS} =3.0V, V_{GS} =0, f=1.0MHz		45		pF
C _{oss}	V_{DS} =3.0V, V_{GS} =0, f=1.0MHz		15		pF
t _{on}	V_{DD} =3.0V, V_{GS} =2.5V, I_{D} =10mA		35		ns
^t off	V_{DD} =3.0V, V_{GS} =2.5V, I_{D} =10mA		80		ns

CMUDM8001

SURFACE MOUNT P-CHANNEL **ENHANCEMENT-MODE SILICON MOSFET**



SOT-523 CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:

- 1) Gate 2) Source
- 3) Drain

MARKING CODE: C8A

DIMENSIONS					
	INCHES		MILLIMETERS		
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX	
Α	0.023	0.031	0.58	0.78	
В	0.002	0.008	0.04	0.20	
С	0.013	0.021	0.34	0.54	
D	0.059	0.067	1.50	1.70	
Е	0.059	0.067	1.50	1.70	
F	0.035	0.043	0.90	1.10	
G	0.020		0.50		
Н	0.031	0.039	0.78	0.98	
J	0.010	0.014	0.25	0.35	

SOT-523 (REV: R2)

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru_4 moschip.ru_9